

**КТ819А÷Г**

www.DataSheet4U.com

## PNP КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО - ПЛАНАРНЫЙ ТРАНЗИСТОР

аАО.336.189 ТУ / 02

Предназначен для применения в ключевых и линейных схемах, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.

★ Изготавливается в корпусе **КТ-28-2 (ТО-220)**.



1. Эмиттер  
2. Коллектор  
3. База

### ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Параметры                                                                                                                       | Обознач. | Ед. измер. | Значение              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------|
| Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{эб} \leq 1 \text{ кОм}$<br>КТ819А<br>КТ819Б<br>КТ819В<br>КТ819Г                 | Укэ max  | В          | 40<br>50<br>70<br>100 |
| Напряжение эмиттер-база                                                                                                         | Уэб max  | В          | 5                     |
| Постоянный ток коллектора                                                                                                       | Ik max   | А          | 10                    |
| Импульсный ток коллектора $t_i \leq 10 \text{ мс}$ , $Q \geq 100$                                                               | Ik и max | А          | 15                    |
| Максимально допустимый постоянный ток базы                                                                                      | Iб max   | А          | 3                     |
| Импульсный ток базы $t_i \leq 10 \text{ мс}$ , $Q \geq 100$                                                                     | Iб и max | А          | 5                     |
| Рассеиваемая мощность при $T_{корп.} \leq 25^\circ \text{C}$<br>Диапазон рабочих температур среды $-60$ до $100^\circ \text{C}$ | Рк max   | Вт         | 60                    |

### ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ( $T_{окр.ср.}=25^\circ \text{C}$ )

| Параметры                                                              | Обозначен | Ед. измер | Режимы измерения                            | Min                  | Max |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|-----|
| Обратный ток коллектора                                                | Ikбо      | мА        | Укб=40В                                     |                      | 1   |
| Статический коэффициент передачи тока<br>КТ819А, В<br>КТ819Б<br>КТ819Г | $h_{21э}$ |           | Укб = 5 В, Ik=2А                            | 15<br>20<br>12       |     |
| Граничное напряжение<br>КТ819А<br>КТ819Б<br>КТ819В<br>КТ819Г           | Укэо гр   | В         | Iэ =0.3 А,<br>$t_i= 270\div330 \text{ мкс}$ | 25<br>40<br>60<br>80 |     |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер                                 | Укэ нас   | В         | Ik=5А, Iб=0.5А                              |                      | 2   |

220108, г.Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"

Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32

E-mail: [market@transistor.com.by](mailto:market@transistor.com.by) <http://www.transistor.by>